

本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 9月26日

出 願 番 号 Application Number:

特願2001-294702

出 願 人 Applicant(s):

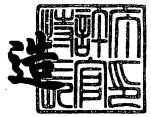
セイコーエプソン株式会社

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

2001年11月26日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

J0086028

【提出日】

平成13年 9月26日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02F 1/133

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

伊藤 昭彦

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】

セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】

上柳 雅誉

【連絡先】

0266-52-3139

【選任した代理人】

【識別番号】

100107076

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤綱 英吉

【選任した代理人】

【識別番号】

100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2001-67646

【出願日】

平成13年 3月 9日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0109826

.

【プルーフの要否】

延

【書類名】 明細書

【発明の名称】

電気光学素子の駆動方法、駆動装置及び電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電気光学素子がフレーム期間を通じて表示すべき階調を規定する 階調データに対応する期間の間、前記電気光学素子をオンにすることにより、前 記電気光学素子に前記階調を表示させる電気光学素子の駆動方法であって、

前記階調データに対応する期間を確保するために用いる相互に連続する複数の 第1のサブフィールド期間、及び該複数の第1のサブフィールド期間に連続し、 それぞれが前記複数の第1のサブフィールド期間及び他の一の第1のサブフィー ルド期間の合計期間の長さに実質的に相当する、相互に連続する複数の第2のサ ブフィールド期間を、前記複数の第1のサブフィールド期間及び前記複数の第2 のサブフィールド期間の境界に接して位置する第1のサブフィールド期間及び第 2のサブフィールド期間から前記境界から最も離れて位置する第1のサブフィー ルド期間及び第2のサブフィールド期間の方向に前記階調データに従って順次選 択する選択ステップと、

選択された前記サブフィールド期間の間、前記電気光学素子をオンにする駆動ステップとを含むことを特徴とする電気光学素子の駆動方法。

【請求項2】 前記複数の第1のサブフィールド期間及び前記複数の第2のサブフィールド期間は、同一のフレーム期間に含まれることを特徴とする請求項1記載の電気光学素子の駆動方法。

【請求項3】 前記複数の第1のサブフィールド期間及び前記複数の第2のサブフィールド期間の一部のサブフィールド期間は、連続する2つのフレーム期間のうちの一方のフレーム期間に含まれ、他部のサブフィールド期間は、他方のフレーム期間に含まれることを特徴とする請求項1記載の電気光学素子の駆動方法。

【請求項4】 前記一部のサブフィールド期間は、前記複数の第1のサブフィールド期間及び前記複数の第2のサブフィールド期間のうちの一方のサブフィールド期間であり、前記他部のサブフィールド期間は、他方のサブフィールド期間であることを特徴とする請求項3記載の電気光学素子の駆動方法。

【請求項5】 前記駆動ステップは、前記階調データに拘わらず、前記境界に接

して位置する前記第1のサブフィールド期間の間、前記電気光学素子をオンにすることを特徴とする請求項1記載の電気光学素子の駆動方法。

【請求項6】 前記選択ステップは、前記階調データが零を表すとき、前記境界に接して位置する前記第1のサブフィールド期間の間、前記電気光学素子をオフにすることを特徴とする請求項5記載の電気光学素子の駆動方法。

【請求項7】 上記階調データは、2のN乗の種類を有する前記階調を規定する ためのN個のビット(Nは、2以上の整数)からなり、

前記N個のビットのうちの上位側M個のビットは、前記複数の第2のサブフィールド期間が表示すべき階調を規定し、

前記N個のビットのうちの下位側(N-M)個のビットは、前記複数の第1のサブフィールド期間が表示すべき階調を規定し、

前記Mは、前記フレーム期間が($2^{N-M}-1$)個の第1のサブフィールド期間を含むことを想定したときに与えられるMの最適解であることを特徴とする請求項1記載の電気光学素子の駆動方法。

【請求項8】 上記階調データは、2のN乗の種類を有する前記階調を規定する ためのN個のビット(Nは、2以上の整数)からなり、

前記各第2のサブフィールド期間の長さは、前記N個のビットに含まれる上位 側M個のビットのうちの最下位ビットが規定する階調を表すための期間の長さに 相当し、

前記複数の第2のサブフィールド期間の個数は、前記M個のビットにより表される最大の数に相当し、

前記各第1のサブフィールド期間の長さは、前記N個のビットに含まれる下位側(N-M)個のビットのうちの最下位ビットが規定する階調を表すための期間の長さに相当し、

前記複数の第1のサブフィールド期間の個数は、前記(N-M)個のビットにより表される最大の数に相当することを特徴とする請求項1記載の電気光学素子の駆動方法。

【請求項9】 電気光学素子が複数のフレーム期間を通じて表示すべき階調を規定する階調データに対応する期間の間、前記電気光学素子をオンにすることによ

り、前記電気光学素子に前記階調を表示させる電気光学素子の駆動方法であって

前記複数のフレーム期間を構成する各フレーム期間に含まれる、前記階調データに対応する期間を特定するために用いる相互に連続する複数の第1のサブフィールド期間、及び該複数の第1のサブフィールド期間に連続し、それぞれが前記複数のフレーム期間に含まれる全ての第1のサブフィールド期間及び他の一の第1のサブフィールド期間の合計期間の長さに実質的に相当する、相互に連続する複数の第2のサブフィールド期間を、前記各フレーム期間毎に、前記複数の第1のサブフィールド期間及び前記複数の第2のサブフィールド期間の境界に接して位置する第1のサブフィールド期間及び第2のサブフィールド期間から前記境界から最も離れて位置する第1のサブフィールド期間及び第2のサブフィールド期間の方向に前記階調データに従って順次選択する選択ステップと、

前記各フレーム期間毎に、選択された前記サブフィールド期間の間、前記電気 光学素子をオンにする駆動ステップと、

を含むことを特徴とする電気光学素子の駆動方法。

【請求項10】 前記選択ステップは、前記各フレーム期間毎に選択すべき第1のサブフィールド期間の個数を、前記階調データのうち前記複数のフレーム期間に含まれる前記複数の第1のサブフィールド期間を通じて表示すべき階調を規定する階調データ部分に従って決定することを特徴とする請求項9記載の電気光学素子の駆動方法。

【請求項11】 前記選択ステップは、前記複数のフレーム期間を通じて表示すべき前記階調と、前記各フレーム期間に前記複数の第1のサブフィールド期間及び前記複数の第2のサブフィールド期間のうちの選択すべきサブフィールド期間の位置との対応関係を規定する表に従って、選択することを特徴とする請求項9記載の電気光学素子の駆動方法。

【請求項12】 上記階調データは、2のN乗の種類を有する前記階調を規定するためのN個のビット(Nは、2以上の整数)からなり、

前記N個のビットのうちの上位側M個のビットは、前記複数の第2のサブフィールド期間が表示すべき階調を規定し、

前記N個のビットのうちの下位側(N-M)個のビットは、前記複数の第1のサブフィールド期間が表示すべき階調を規定し、

or and all the

前記Mは、前記Dレーム期間が($2^{N-M}-1$)/F個(Fは、前記複数のフレームの数を表す)の第1のサブフィールド期間を含むことを想定したときに与えられるMの最適解であることを特徴とする請求項9記載の電気光学素子の駆動方法。

【請求項13】 前記($2^{N-M}-1$)/Fが余りを生じるときには、前記第1のサブフィールド期間の数として、前記($2^{N-M}-1$)/Fの商に1を加算した数を用いることを特徴とする請求項12記載の電気光学素子の駆動方法。

【請求項14】 電気光学素子がフレーム期間を通じて表示すべき階調を規定する階調データに対応する期間の間、前記電気光学素子をオンにすることにより、前記電気光学素子に前記階調を表示させる電気光学素子の駆動装置であって、

前記階調データに対応する期間を特定するために用いる相互に連続する複数の第1のサブフィールド期間、及び該複数の第1のサブフィールド期間に連続し、それぞれが前記複数の第1のサブフィールド期間及び他の一の第1のサブフィールド期間の合計期間の長さに実質的に相当する、相互に連続する複数の第2のサブフィールド期間を、前記複数の第1のサブフィールド期間及び前記複数の第2のサブフィールド期間の境界に接して位置する第1のサブフィールド期間及び第2のサブフィールド期間から前記境界から最も離れて位置する第1のサブフィールド期間及び第2のサブフィールド期間の方向に前記階調データに従って選択する選択回路と、

選択された前記サブフィールド期間の間、前記電気光学素子をオンにする駆動 回路とを含むことを特徴とする電気光学素子の駆動装置。

【請求項15】 電気光学素子が複数のフレーム期間を通じて表示すべき階調を 規定する階調データに対応する期間の間、前記電気光学素子をオンにすることに より、前記電気光学素子に前記階調を表示させる電気光学素子の駆動装置であっ て、

各フレーム期間に含まれる、前記階調データに対応する期間を特定するために 用いる相互に連続する複数の第1のサブフィールド期間、及び該複数の第1のサ

ブフィールド期間に連続し、それぞれが前記複数のフレーム期間に含まれる全ての第1のサブフィールド期間及び他の一の第1のサブフィールド期間の合計期間の長さに実質的に相当する、相互に連続する複数の第2のサブフィールド期間を、前記各フレーム期間毎に、前記複数の第1のサブフィールド期間及び前記複数の第2のサブフィールド期間の境界に接して位置する第1のサブフィールド期間及び第2のサブフィールド期間から前記境界から最も離れて位置する第1のサブフィールド期間及び第2のサブフィールド期間の方向に前記階調データに従って選択する選択回路と、

前記各フレーム期間毎に、選択された前記サブフィールド期間の間、前記電気 光学素子をオンにする駆動回路と、

を含むことを特徴とする電気光学素子の駆動装置。

【請求項16】 マトリクス状に配置された複数の電気光学素子を含み、電子機器に関連する画像を表示するための表示装置と、

請求項14記載の電気光学素子の駆動装置とを備えることを特徴とする電子機 器。

【請求項17】 マトリクス状に配置された複数の電気光学素子を含み、電子機器に関連する画像を表示するための表示装置と、

請求項15記載の電気光学素子の駆動装置とを備えることを特徴とする電子機 器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、パルス幅変調を用いて、電気光学素子である画素を駆動する画素の 駆動方法、駆動装置及び電子機器に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来、マトリクス状に配置された複数の画素を、該画素を選択するための走査 信号及び前記画素が表示すべき階調を規定するためのデータ信号を用いて駆動す るという画素の駆動方法が用いられている。該画素の駆動方法のうち、表示画像

の画質を向上させる等のために、1フレーム内に設けられている複数の期間(以下、「サブフィールド」という。)の各期間に、前記データ信号の印加を全ての画素について行うというサブフィールド駆動が提案されている。該サブフィールド駆動によれば、前記各サブフィールドで、各画素に前記データ信号としてオン(例えば、白)を表すための電圧(例えば、ハイパルス)及びオフ(例えば、黒)を表すための電圧の2つの電圧(ローパルス)のうちのいずれかを印加し、これにより、1フレーム内で各画素に前記データ信号によりパルス幅変調を施し、その結果として、前記画素に、例えば64階調のうちの一つの階調を表示させることができる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

しかしながら、従来の2^N階調でN個のサブフィールドで駆動するような場合、 前記フレームに含まれる前記複数のサブフィールドの中から、前記オンの電圧を 印加すべきサブフィールドが何ら規則性無く選択されることから、例えば、本来 同一階調を表示しなければならないにも拘わらず、選択された前記サブフィール ド同士の位置関係の無規則性に起因して、異なる階調を表示するという問題があった。

[0005]

図32は、従来のサブフィールドの選択を示す。図32に示すように、1フレーム内でオンのためのハイパルスが連続しないAのデータ信号の波形と、ハイパルスが連続するBのデータ信号の波形とを比較すると、ハイパルスの長さの合計がAとBとで同じであるにも拘らず、Aのデータ信号の波形により表示される階調が、Bのデータ信号の波形により表示される階調より高い、即ち、明るいという問題があった。

[0006]

また、 2^N 階調で(2^N-1)個のサブフィールドで駆動するような場合、サブフィールド数が多く、1フレーム期間に画素に電圧を書き込む回数が増加し、消費電力が増える。

さらに、階調の数を増加させること、即ち、多階調化に伴い各サブフィールドの長さをより短くしなければならないことから、前記データ信号の印加を時間的な制約の下に行わなければならず、前記データ信号の印加を高精度に制御することが困難であるという問題もあった。

[0007]

上記問題を解決するために、本発明の目的は、不規則に選択されるサブフィールドの位置に起因する階調の相違を回避することができる画素の駆動方法、駆動回路及び電子機器を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明に係る電気光学素子の駆動方法は、電気光学素子がフレーム期間を通じて表示すべき階調を規定する階調データに対応する期間の間、前記電気光学素子をオンにすることにより、前記電気光学素子に前記階調を表示させる電気光学素子の駆動方法であって、前記階調データに対応する期間を確保するために用いる相互に連続する複数の第1のサブフィールド期間、及び該複数の第1のサブフィールド期間に連続し、それぞれが前記複数の第1のサブフィールド期間及び他の一の第1のサブフィールド期間の合計期間の長さに実質的に相当する、相互に連続する複数の第2のサブフィールド期間を、前記複数の第1のサブフィールド期間及び前記複数の第2のサブフィールド期間の境界に接して位置する第1のサブフィールド期間及び第2のサブフィールド期間の境界に接して位置する第1のサブフィールド期間を第2のサブフィールド期間の方向に前記階調データに従って順次選択する選択ステップと、選択された前記サブフィールド期間の間、前記電気光学素子をオンにする駆動ステップとを含むことを特徴とする

[0009]

本発明に係る他の電気光学素子の駆動方法は、電気光学素子が複数のフレーム 期間を通じて表示すべき階調を規定する階調データに対応する期間の間、前記電 気光学素子をオンにすることにより、前記電気光学素子に前記階調を表示させる 電気光学素子の駆動方法であって、前記複数のフレーム期間を構成する各フレー

ム期間に含まれる、前記階調データに対応する期間を特定するために用いる相互に連続する複数の第1のサブフィールド期間、及び該複数の第1のサブフィールド期間に連続し、それぞれが前記複数のフレーム期間に含まれる全ての前記複数の第1のサブフィールド期間及び他の一の第1のサブフィールド期間の合計期間の長さに実質的に相当する、相互に連続する複数の第2のサブフィールド期間を、前記各フレーム期間毎に、前記複数の第1のサブフィールド期間及び前記複数の第2のサブフィールド期間の境界に接して位置する第1のサブフィールド期間及び第2のサブフィールド期間から前記境界から最も離れて位置する第1のサブフィールド期間及び第2のサブフィールド期間の方向に前記階調データに従って順次選択する選択ステップと、前記各フレーム期間毎に、選択された前記サブフィールド期間の間、前記電気光学素子をオンにする駆動ステップと、を含むことを特徴とする。

[0010]

本発明に係る電気光学素子の駆動装置は、電気光学素子がフレーム期間を通じて表示すべき階調を規定する階調データに対応する期間の間、前記電気光学素子をオンにすることにより、前記電気光学素子に前記階調を表示させる電気光学素子の駆動装置であって、前記階調データに対応する期間を特定するために用いる相互に連続する複数の第1のサブフィールド期間、及び該複数の第1のサブフィールド期間に連続し、それぞれが前記複数の第1のサブフィールド期間及び他の一の第1のサブフィールド期間の合計期間の長さに実質的に相当する、相互に連続する複数の第2のサブフィールド期間を、前記複数の第1のサブフィールド期間及び前記複数の第2のサブフィールド期間の境界に接して位置する第1のサブフィールド期間及び第2のサブフィールド期間から前記境界から最も離れて位置する第1のサブフィールド期間及び第2のサブフィールド期間の方向に前記階調データに従って選択する選択回路と、選択された前記サブフィールド期間の間、前記電気光学素子をオンにする駆動回路とを含むことを特徴とする。

[0011]

本発明に係る他の電気光学素子の駆動装置は、電気光学素子が複数のフレーム期間を通じて表示すべき階調を規定する階調データに対応する期間の間、前記電

気光学素子をオンにすることにより、前記電気光学素子に前記階調を表示させる電気光学素子の駆動装置であって、各フレーム期間に含まれる、前記階調データに対応する期間を特定するために用いる相互に連続する複数の第1のサブフィールド期間、及び該複数の第1のサブフィールド期間に連続し、それぞれが前記複数のフレーム期間に含まれる全ての第1のサブフィールド期間及び他の一の第1のサブフィールド期間の合計期間の長さに実質的に相当する、相互に連続する複数の第2のサブフィールド期間を、前記各フレーム期間毎に、前記複数の第1のサブフィールド期間及び前記複数の第2のサブフィールド期間の境界に接して位置する第1のサブフィールド期間及び第2のサブフィールド期間の方向に前記階調データに従って選択する選択回路と、前記各フレーム期間毎に、選択された前記サブフィールド期間の間、前記電気光学素子をオンにする駆動回路と、を含むことを特徴とする。

[0012]

本発明に係る電子機器は、マトリクス状に配置された複数の電気光学素子を含み、電子機器に関連する画像を表示するための表示装置と、上記電気光学素子の駆動装置のいずれかとを備えることを特徴とする。

[0013]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。

[第1の実施の形態]

本発明に係る画素の駆動方法であるサブフィールド駆動方法を用いた電気光学 装置について説明する。

図1は、第1の実施の形態の電気光学装置の構成を示す。該電気光学装置は、素子基板及び対抗基板間に複数の画素をマトリクス状に備えており、1フレーム、即ち1フレームの期間に、行方向(X)に並ぶ所定数の画素を同時に選択することを垂直方向に順次行う、即ち、線順次を行うと共に、階調を規定するための信号、即ち、0又は±Vを画素に印加することにより、各画素に前記階調を表示させる。より詳しくは、前記電気光学装置は、例えば、一の行に配列された所定

数の画素を、1フレームを構成する複数のサブフィールドの各サブフィールド毎に選択する。いずれのサブフィールドで前記画素に電圧を印加するかにより、1フレーム内で前記画素にパルス幅変調を施す。これにより、前記画素に印加する電圧実効値を変え、前記画素に1フレーム間に階調を表示させることができる。以下、±Vを印加することを"オン"といい、0を印加することを"オフ"という。なお、液晶は交流駆動を必要とすることから、+Vの印加とーVの印加とは、階調の観点からは実質的に同義である。

[0014]

図10は、サブフィールドを示す。1フレーム(1F)は、図10に示されるように、サブフィールドSF1~SF7から構成されている。サブフィールドSF1~SF3の長さの重み付けは小さく設定されており、他方、サブフィールドSF5~SF7の長さの重み付けは、大きく設定されている。例えば、電気光学装置に供給される、画素が表示すべき階調を規定する階調データが4ビットにより16階調を定めることを想定すると、サブフィールドSF1~SF3の長さは、「1」階調に相当し、他方、サブフィールドSF5~SF7の長さは、「4」階調に相当する。即ち、サブフィールドSF5~SF7の長さは、3つのサブフィールドSF1~SF3の合計の長さと、これらのうちの1つのサブフィールドの長さとを合計した長さに実質的に相当する。液晶の駆動に関する閾値電圧Vthを与えるために、前記サブフィールドSF1~SF3及び前記サブフィールドSF5~SF7の間の設けられているサブフィールドSF4を、階調に拘らず常時オン状態にする。

[001.5]

サブフィールドSF5~SF7のオン/オフ状態は、上記4ビットの階調データの上位2ビットにより定める。換言すれば、サブフィールドSF5~SF7は、前記上位2ビットに従って、サブフィールドSF5からサブフィールドSF7の方向に沿って順次選択される。例えば、上位2ビットが"00"のときは、サブフィールドSF5~SF7の全てをオフ状態にし、"01"のときは、サブフィールドSF5のみをオン状態にし、"10"のときは、サブフィールドSF5

の全てをオン状態にする。

[0016]

サブフィールドSF1~SF3のオン/オフ状態は、上記4ビットの階調データの下位2ビットにより定める。換言すれば、サブフィールドSF1~SF3は、前記下位2ビットに従って、サブフィールドSF3からサブフィールドSF1の方向に沿って順次選択される。例えば、下位2ビットが"00"のときは、サブフィールドSF1~SF3の全てをオフ状態にし、"01"のときは、サブフィールドSF3のみをオン状態にし、"10"のときは、サブフィールドSF3のみをオン状態にし、"11"のときは、サブフィールドSF3の全てをオン状態にする。

[0017]

サブフィールドSF5~SF7及びサブフィールドSF1~SF3のオン/オフ常態についてより詳述すれば、例えば、階調データが「9」階調を規定する"1001"であるとき、図10に示されるように、サブフィールドSF5及びSF6をオン状態にし、かつサブフィールドSF3をオン状態にする。また、例えば、階調データが「14」階調を規定する"1110"であるとき、図10に示されるように、サブフィールドSF5~7の全てをオン状態にし、かつサブフィールドSF2及びSF3をオン状態にする。

[0018]

ここで、20N乗(Nは、2以上の整数)の階調数の階調を規定するNビットの階調データを上位Mビット(Mは、Nより小さい正の整数)と下位(N-M)ビットとに分けることを想定すると、前記下位(N-M)ビットに対応する複数の第1のサブフィールドの個数、及び前記上位Mビットに対応する複数の前記第2のサブフィールドの個数は、それぞれ、($2^{N-M}-1$)個、($2^{M}-1$)個であり、さらに、前記第1のサブフィールドの重み付けが α であることを想定すると、前記第2のサブフィールドの重み付けは、 α 2 $^{N-M}$ になる。

[0019]

上記したように、前記階調データに応じて、相互に連続する複数のサブフィールド(SF5~SF7)と、相互に連続する複数のサブフィールド(SF1~S

F3)とを、実質的に相互に隣接するサブフィールドSF5及びSF3間の境界から、換言すれば、サブフィールドSF4からサブフィールドSF1またはサブフィールドSF7の方向に順番に選択することから、すなわち、上記サブフィールドSF1~SF3、サブフィールドSF5~SF7を、フレーム期間の中央から外側へ順次選択する。したがって、階調データの値に拘わらず、オン状態にすべきサブフィールドを連続的に選択することができ、これにより、サブフィールドの非連続性に起因する階調の不具合いの発生を回避することが可能になる。

[0020]

また、上位ビットのサブフィールドと下位ビットのサブフィールドとの境界に 常時オンとすべきサブフィールドSF4を設けることにより、上記の連続性を維 持した上で、液晶の特性に応じた電圧実効値を液晶に印加することができること から、階調制御を的確に行なうことができる。

[0021]

図1に戻り、電気光学装置は、図1に示されるように、表示部101aと、発振回路150と、タイミング信号生成回路200と、データ変換回路300と、走査線駆動回路130と、データ線駆動回路140とを含む。

[0022]

表示部101 aには、前記複数の画素110がm行×n列に配置されており、 該複数の画素110を選択するための走査線112がX(行)方向に延在して形成され、他方、前記複数の画素110に前記階調を規定するデータ信号114が Y(列)方向に延在して形成されている。

[0023]

タイミング信号生成回路200には、上位装置(図示せず)から供給される垂直同期信号Vs、水平同期信号Hsおよび入力階調データD0~D3のドットクロック信号DCLK、並びに発振回路150から供給される読み出しタイミングの基本クロックRCLKに基づき、図1に示されるような信号LCOM、FR、DY、CLY、LP、及びCLXを生成する。

[0024]

駆動信号LCOMは、前記複数の画素110を駆動するために対向基板の対向

電極に印加される一定電位(零電位)である。交流化信号FRは、1フレーム毎に、液晶への印加電圧を極性反転するタイミングを指し示す。スタートパルスDYは、各サブフィールドSF1~SF7の位置を指し示す。クロック信号CLYは、走査側(Y側)の水平走査期間を規定するために用いられる。ラッチパルスLPは、水平走査期間(1H)を規定する。クロック信号CLXは、表示用のドットクロック信号である。

[0025]

データ変換回路300は、4ビットで16階調を規定する階調データD0~D3を供給される。ここで、例えば、D3は、最上位ビットであり、他方、D0は、最下位ビットである。データ変換回路300は、前記階調データD0~D3に基づきデータ信号Dsを生成し、該データ信号Dsをデータ線駆動回路140に出力する。

[0026]

走査線駆動回路130は、前記タイミング生成回路200から出力される信号 DY及びCLYに基づき、表示部101aに含まれるm本の走査線112に、走査信号G1、G2、G3、・・・、G240をそれぞれ供給して、水平走査期間1Hの期間に前記m本の走査線112のそれぞれを複数回選択し、より具体的には、1フレームが図10に示す7個のサブフィールドから構成されているときには、1フレーム内で各走査線112を7回選択し、また、データ線駆動回路140は、選択された走査線112に係る1行分の画素110に対し、n本のデータ線114を介して、データ信号d1、d2、d3、・・・、d320をそれぞれ供給する。

[0027]

データ線駆動回路140は、前記タイミング生成回路200から出力される信号FR、LP及びCLX、並びに前記データ変換回路300から出力されるデータ信号Dsに基づき、前記表示部101aに設けられているn本のデータ線114にデータ信号d1、d2、...、dnを供給する。

[0028]

図2は、表示部に設けられている画素の構成を示す。図に示されるように、薄

膜トランジスタ(TFT)116のゲート、ソース及びドレインが前記走査線1 12、前記データ線114、及び画素電極118にそれぞれ接続されており、画 素電極118と対向電極108との間に電気光学材料たる液晶105が挟持され ている。画素電極118と対向電極108との間には電荷を保持するための蓄積 容量119が形成されている。

[0029]

画素電極118への印加電圧及びデータ線114への印加電圧間のオフセット電圧を軽減するためには、図2(a)に示された構成の画素より、図2(b)に示された、Pチャネル型トランジスタとNチャネル型トランジスタとを相補的に組み合わせた構成の画素が望ましい。図2(a)に示すように、一方のチャンネル型のトランジスタが用いられている場合は、オフセット電圧が必要になる。

[0030]

図3(a)、(b)は、電気光学装置の構造を示す。該電気光学装置100は、図1に示された構成要素に加えて、例えば、シール材104、遮光膜106、偏向板、配向膜及びカラーフィルタを備えている。

[0031]

図4は、データ線駆動回路の構成を示す。図1に示したデータ線駆動回路14 0は、図4に示されるように、Xシフトレジスタ1402と、第1のラッチ回路 1404と、第2のラッチ回路1406と、電位選択回路1408とから構成さ れている。

Xシフトレジスタ1402は、タイミング生成回路200から供給されるラッチパルスLPを、前記タイミング生成回路200から供給されるクロック信号CLXに従ってラッチ信号S1、S2、S3、・・・、Snとして第1のラッチ回路1404に順次供給する。

[0032]

第1のラッチ回路1404は、データ変換回路300から出力される前記データ信号Dsを、前記ラッチ信号S1、 S2、S3、・・・、Snの立ち下がりで順次ラッチする。第2のラッチ回路1406は、第1のラッチ回路1404によりラッチされた前記データ信号Dsを前記ラッチパルスLPの立ち下がりで一

斉にラッチし、電位選択回路1408に転送する。

[0033]

電位選択回路1408は、タイミング生成回路200から出力される前記交流化信号FRに基づき、前記ラッチしたデータ信号Dsをデータ信号d1、d2、d3、…dnに変換し、データ線114に印加する。すなわち、交流化信号FRがLレベルであるときは、データ信号d1、d2、d3、…dnのHレベルを+V1に変換し、他方、交流化信号FRがHレベルであるときには、データ信号d1、d2、d3、…dnのHレベルをーV1に変換する。交流化信号FRがLであるかHであるかに拘わらず、データ信号d1、d2、d3、…dnのLレベルを0電位に変換する。

[0034]

図5は、スタートパルス発生回路の構成を示し、また、 図6は、スタートパルス発生回路の動作を示すタイムチャートである。スタートパルス発生回路210は、図1に示したタイミング生成回路200に設けられており、スタートパルスDYを生成する。

[0035]

スタートパルス発生回路 2 1 0 は、図 5 に示されるように、カウンタ 2 1 1、コンパレータ 2 1 2、マルチプレクサ 2 1 3、リングカウンタ 2 1 4、 Dフリップフロップ 2 1 5、およびオア回路 2 1 6 から構成されている。

カウンタ211は、クロック信号CLYに同期するラインクロック信号LCL Kをカウントし、そのカウント値は、オア回路216の出力信号によってリセットされる。

[0036]

リングカウンタ214は、スタートパルスDYの数をカウントし、マルチプレクサ213は、リングカウンタ214のカウント結果S214に基づいて、サブフィールドSF1~SF7の時間を示す計数データDc1、Dc2、・・・、Dc7を選択出力する。

コンパレータ212は、カウンタ211のカウント値S211とマルチプレクサ213の出力データ値S213とを比較し、両者が一致するとき、Hレベルで

ある一致信号S212を出力する。コンパレータ212は、カウンタ211のカウント値S211が、サブフィールドの区切りに達すると一致信号S212を出力する。該一致信号は、オア回路216を介してカウンタ211のリセット端子にフイードバックされることから、カウンタ211は、サブフィールドの区切りから再びカウントを開始する。

[0037]

Dフリップフロップ215は、オア回路216の出力信号を、ラインクロック信号LCLKによってラッチして、スタートパルスDYを生成する。

オア回路216の一方の入力端には、フレームの開始時に、ラインクロック信号LCLKの1周期の期間だけHレベルとなるリセット信号RSETが供給される。これにより、カウンタ211のカウント値は、フレームの開始時点にリセットされる。

[0038]

一致信号S212が立ち上がると、まず、ラインクロック信号LCLKの立ち上がりタイミングで、スタートパルスDYが立ち上がる。一方、前記ラインクロック信号LCLKの立上りによって、カウント値S211と出力データ値S213とが一致しなくなることから、一致信号S212は、Lレベルになる。従って、次にラインクロック信号LCLKが立ち上がったときに、該Lレベルである一致信号S212がDフリップフロップ215にラッチされることから、スタートパルスDYがLレベルになる。このようにして、各サブフィールドの最初にスタートパルスDYが出力される。

[0039]

図7は、データ変換回路の構成を示す。図1に示したデータ変換回路300は、書き込みアドレス制御部310、デコーダ312、複数のメモリブロック32 1~327、表示アドレス制御部330、及びオア回路332を含む。

デコーダ312は、階調データD0~D3が入力されると、前記階調データD0~D3を各サブフィールドSF1~SF3、SF5~SF7のオン/オフ状態に対応するビットデータであるサブフィールドデータSD1~SD3、SD5~SD7に変換する。メモリブロック321~327は、各々サブフィールドデー

タSD1~SD3、SD5~SD7を記憶するために設けられており、素子基板 101の表示領域(m行×n列)に対応して各々m×nビットのメモリ空間を有 する。メモリブロック321~327は、書込みおよび読出し動作を非同期に、 かつ独立して実行する。

[0040]

書込みアドレス制御部310は、垂直同期信号Vs、水平同期信号Hsおよびドットクロック信号DCLKに同期して、ライトイネーブル信号WEおよび書込みアドレスWADを各メモリブロックに供給する。すなわち、書込みアドレス制御部310は、ドットクロック信号DCLKをカウントアップし、このカウント結果を書込みアドレスWADとして出力するとともに、書込みアドレスWADの値が確定する毎にライトイネーブル信号WEを出力する。また、書込みアドレス制御部310のカウント結果は、垂直同期信号Vsが入力される毎にリセットされる。これにより、各メモリブロック321~327には、そのm×nビットのメモリ空間を順次アクセスする書込みアドレスWADが供給され、サブフィールドデータSD1~SD3、SD5~SD7は対応するメモリブロック内の表示位置に応じたアドレスに順次格納される。

[0041]

表示アドレス制御部330は、上記各サブフィールド期間が開始されると、対応する表示行のビットデータをアクセスするアドレス信号RADを出力する。アドレス信号RADは、クロック信号CLXに同期し表示列数に応じて「n-1」回インクリメントされる。これにより、対応する表示行に対して第1列~第n列のビットを順次アクセスするようなアドレス信号RADが出力される。

[0042]

読出し信号RD1~3、RD5~7は、各々対応するサブフィールドSF1~SF3、SF5~SF7の期間中は常にイネーブル状態になり、それ以外のサブフィールド期間においてはオフ状態にされる。これにより、各サブフィールドSF1~SF3、SF5~SF7で、対応する一つのメモリブロックのみが読出し可能な状態になり、他のメモリブロックは読出し禁止状態になる。これにより、サブフィールドSF1が開始されると、メモリブロック321から、m行×n列

のサブフィールドデータSD1が順次読み出される。

[0043]

サブフィールドSF2、SF3においても、同様にメモリブロック322、323がアクセスされ、各々m行×n列のサブフィールドデータSD2、SD3が順次読み出される。次に、サブフィールドSF4においては、オン信号S $_$ on がHレベルに保持される。なお、オン信号S $_$ onは、サブフィールドSF4以外の期間においてはLレベルに保持される。次に、サブフィールドSF5~SF7においても、同様にメモリブロック325~327がアクセスされ、各々m行×n列のサブフィールドデータSD5~SD7が順次読み出される。オア回路332は、これらサブフィールドデータSD1~SD3、SD5~SD7およびオン信号S $_$ onの論理和をデータ信号Dsとして出力する。

[0044]

図8は、デコーダが用いる真理値表を示す。デコーダ312が用いる該真理値表は、階調データと、サブフィールドSF1~SF3、SF5~SF7のオン/オフを規定する、サブフィールドデータ(SD1~SD3、SD5~SD7)中の1または0との対応関係を示す。例えば、「5」階調(0101)を表すためには、サブフィールドデータSD3及びSD5が1であることから、サブフィールドSF3及びSF5をオン状態にする。

[0045]

図9は、第1の実施の形態の信号の波形を示す。流化信号FRがLレベルとなる1フレーム(1F)において、スタートパルスDYが供給されると、走査線駆動回路130によるクロック信号CLYに従う転送によって、走査信号G1、G2、G3、・・・Gmが期間(t)に順次排他的に出力される。期間(t)は、最も短いサブフィールドSF1よりもさらに短い期間に設定されている。

[0046]

走査信号G1、G2、G3、・・・、Gmは、それぞれクロック信号CLYの 半周期に相当するパルス幅を有し、また、上から数えて1本目の走査線112に 対応する走査信号G1は、スタートパルスDYが供給された後、クロック信号C LYが最初に立ち上がってから、少なくともクロック信号CLYの半周期だけ遅

延して出力される構成となっている。したがって、スタートパルスDYが供給されてから、走査信号G1が出力されるまでに、ラッチパルスLPの1ショット(G0)がデータ線駆動回路140に供給される。

[0047]

まず、このラッチパルスLPの1ショット(GO)がデータ線駆動回路140に 供給されると、データ線駆動回路140におけるクロック信号CLXにしたがっ た転送によって、ラッチ信号S1、S2、S3、・・・、Snが、水平走査期間 (1H)に順次排他的に出力される。なお、ラッチ信号S1、S2、S3、・・ ・、Snは、それぞれクロック信号CLXの半周期に相当するパルス幅を有する

[0048]

図4の第1のラッチ回路1404は、ラッチ信号S1の立ち下がりにおいて、上から数えて1本目の走査線112と、左から数えて1本目のデータ線114との交差に対応する画素110へのデータ信号Dsをラッチし、次に、ラッチ信号S2の立ち下がりにおいて、上から数えて1本目の走査線112と、左から数えて2本目のデータ線114との交差に対応する画素110へのデータ信号Dsをラッチし、以下、同様に、上から数えて1本目の走査線112と、左から数えてn本目のデータ線114との交差に対応する画素110へのデータ信号Dsをラッチする。

[0049]

これにより、まず、図1において上から1本目の走査線112との交差に対応する画素1行分のデータ信号Dsが、第1のラッチ回路1404により点順次的にラッチされる。なお、データ変換回路300は、第1のラッチ回路1404によるラッチのタイミングに合わせて、各画素の階調データD0~D3をデータ信号Dsに変換して出力する。

[0050]

次に、クロック信号CLYが立ち下がって、走査信号G1が出力されると、図 1において上から数えて1本目の走査線112が選択される結果、当該走査線1 12との交差に対応する画素110のトランジスタ116がすべてオンとなる。

一方、当該クロック信号CLYの立ち下がりによってラッチパルスLPが出力される。そして、このラッチパルスLPの立ち下がりタイミングにおいて、第2のラッチ回路1406は、第1のラッチ回路1404によって点順次的にラッチされたデータ信号Dsを、電位選択回路1408を介して、対応するデータ線114の各々にデータ信号d1、d2、d3、・・・、dnとして一斉に供給する。このため、上から数えて1行目の画素110においては、データ信号d1、d2、d3、・・・、dnの書込が同時に行われる。

[0051]

この書込と並行して、図1において上から2本目の走査線112との交差に対応する画素1行分のデータ信号Dsが、第1のラッチ回路1404により点順次的にラッチされる。そして、以降同様な動作が、m本目の走査線112に対応する走査信号Gmが出力されるまで繰り返される。すなわち、ある走査信号Gi(iは、1<i<mを満たす整数)が出力される1水平走査期間(1H)においては、i本目の走査線112に対応する画素110の1行分に対するデータ信号は1、d2、d3、・・・、dnの書込と、(i+1)本目の走査線112に対応する画素110の1行分に対するデータ信号Dsの点順次的なラッチとが並行して行われる。なお、画素110に書き込まれたデータ信号は、次のサブフィールドSF2における書込まで保持される。

[0052]

以下同様な動作が、サブフィールドの開始を規定するスタートパルスDYが供給される毎に繰り返される。さらに、1フレーム経過後、交流化信号FRがHレベルに反転した場合においても、各サブフィールドにおいて同様な動作が繰り返される。

[0053]

[第2の実施の形態]

第2の実施の形態の電気光学装置について、図11~図14を参照して説明する。

図14は、第2の実施の形態のサブフィールドを示す。図14と第1の実施の 形態のサブフィールドを示す図10との比較から明らかであるように、第2の実

施の形態のフレーム1Fには、階調データに拘わらずオフ状態にするサブフィールドSF8が追加されている。

[0054]

図11は、第2の実施の形態のスタートパルス発生回路の構成を示し、図12は、第2の実施の形態のデータ変換回路の構成を示し、図13は、第2の実施の形態の信号の波形を示す。第2の実施の形態の電気光学装置は、上記サブフィールドSF8を用いて動作すべく、図11に示されたスタートパルス発生回路210及び図12に示されたデータ変換回路300を有する。スタートパルス発生回路210では、図11に示されるように、サブフィールドSF8に対応する期間を発生するための計数データDc8がマルチプレクサ213aに供給される。データ変換回路300では、図12に示すように、表示アドレス制御部330aが、スタートパルスDYがサブフィールドSF8を指し示すときのみS-off信号を出力する。

[0055]

第2の実施の形態の電気光学装置によれば、階調を微調整するためにサブフィールドSF1~SF7の何れかの期間を多少増減する必要が生じたとき、他のサブフィールドSF1~SF3、SF5~SF7の長さを増減することなく、サブフィールドSF8の期間のみを前記増減を要する長さだけ増減することにより前記階調を微調整することができることから、前記階調の微調整を容易に行うことが可能になる。

[0056]

[第3の実施の形態]

第3の実施の形態の電気光学装置は、第1及び第2の実施形態の電気光学装置より一層の多階調を表示することを特徴とする。第3の実施の形態の電気光学装置について、図15~図18を参照して説明する。

[0057]

図18は、第3の実施の形態のサブフィールドを示す。第3の実施の形態の電気光学装置では、該電気光学装置に入力される6ビットの階調データD0~D5が規定する64階調を表示すべく、1フレーム(1F)は、図18に示されるよ

うに、7個のサブフィールドSF1~SF7、7個のサブフィールドSF9~SF15、及びサブフィールドSF8を有する。サブフィールドSF1~SF7の長さは、「1」階調の重み付けを有し、サブフィールドSF9~SF15の長さは、「8」階調の重み付けを有する。液晶の動作特性により規定される閾値電圧Vthを与えるべく、サブフィールドSF8を、階調に拘らず常時オン状態にされる。

[0058]

サブフィールドSF1~SF7のオン/オフ状態は、階調データD0~D5の下位3ビット(D0~D2)により規定され、他方、サブフィールドSF9~SF15のオン/オフ状態は、階調データD0~D5の上位3ビット(D3~D5)により規定される。例えば、階調データD0~D5が、「10」階調を示す「001010」であるとき、サブフィールドSF6及びSF7をオン状態にし、かつサブフィールドSF9をオン状態にし、また、階調データD0~D5が、「28」階調を示す「011100」であるとき、サブフィールドSF4~SF7をオン状態し、かつサブフィールドSF9~SF11をオン状態にする。

[0059]

このように、サブフィールドSF1~SF7、及びサブフィールドSF9~SF15を、下位ビット(D0~D2)の値の増加及び上位ビット(D3~D5)の値の増加に従って、サブフィールドSF7及びSF9間の実質的な境界を基点としてフレームの外側の方向へ順々に選択することにより、第1の実施の形態と同様に、選択されるサブフィールドの連続性を確保することが可能になる。

なお、6ビットの階調データをD0~D5を3ビットずつに分割することに代えて、例えば、上位2ビット及び下位4ビットに分割することも可能である。

[0060]

図15は、第3の実施の形態のスタートパルス発生回路の構成を示し、図16は、第3の実施の形態のデータ変換回路の構成を示し、図17は、第3の実施の形態の電気光学装置の動作を示す。上記の動作を行うべく、第3の実施の形態の電気光学装置は、図15に示されたスタートパルス発生回路、及び図16に支援されたデータ変換回路を有する。

スタートパルス発生回路 2 1 0 では、図15に示されるように、サブフィールド SF1~SF15に対応する期間を発生するための計数データDc1~Dc15 がマルチプレクサ 2 1 3 bに供給される。データ変換回路 3 0 0 では、図16に示されるように、デコーダ 3 1 2 bは、階調データD0~D6を供給され、サブフィールドデータSD1~SD7、SD9~SD15を出力し、また、表示アドレス制御部 3 3 0 bは、スタートパルスDYがサブフィールドSF1~SF15 を指し示す毎に、読出し信号RD1~RD7、RD9~RD15を出力する。

[0061]

[第4の実施の形態]

第4の実施の形態の電気光学装置について図19を参照して説明する。

図19は、第4の実施の形態のサブフィールドを示す。第4の実施の形態の電気光学装置は、図19に示されるように、第1の実施の形態で説明した、階調データに拘わらず常時オン状態にすべきサブフィールドSF4を、原則としてオン状態にし、他方、前記階調データが0000のときのみ、オフ状態にする。これにより、コントラストを上げ画質を向上することが可能になる。

[0062]

[第5の実施の形態]

第5の実施の形態の電気光学装置について図20を参照して説明する。

図20は、第5の実施の形態のサブフィールドを示す。第5の実施の形態の電気光学装置は、図20に示されるように、階調に従って選択すべきサブフィールドを、相互に隣接するフレーム間の境界Pで連続させる。言い換えれば、前記階調に応じて、前記境界Pを基点としてフレームの中央の方向にサブフィールドを順次選択する。これにより、選択されるサブフィールドの連続性を、隣接するフレーム間に亘って確保することが可能になる。

[0063]

[第6の実施の形態]

第6の実施の形態の電気光学装置について図21~図25を参照して説明する。第6の実施の形態の電気光学装置は、上記した第1~第5の実施の形態で説明した、選択されるサブフィールドの連続性を確保する技術と、FRC (frame Ra

tio Control)変調とを組み合わせることを特徴とする。

[0064]

FRC変調とは、1つのフレーム期間を通じて階調を表示するのではなく、相互に連続する複数のフレームを通じて階調を表示することをいう。例えば、2つの連続するフレームを用いて64階調のうちの「11」階調を表示しようとするときには、1番めのフレームで、「6」階調を表示し、2番めのフレームで「5」階調を表示する。また、例えば、3つの連続するフレームを用いて64階調のうちの「11」階調を表示しようとするときには、1番めのフレームで「4」階調を表示し、2番めのフレームで「3」階調を表示し、2番めのフレームで「3」階調を表示する。表示すべき階調が、64階調、128階調、256階調のように一層大きくなることに伴い、低階調を表示するためのサブフィールド、例えば、「1」階調に相当する長さを有するサブフィールドの長さが短くならざるを得ないことから、FRC変調は、特に、低階調を表示するためのサブフィールドのオン/オフを高精度に制御することに適する。

[0065]

ここで、階調データを構成するNビットが、上位Mビット(Mは、Nより小さい正の整数)及び下位(N-M)ビットからなり、第1のサブフィールドが、前記下位(N-M)ビット中の最下位ビットの重み付けに相当する第1の重み付けを有し、第2のサブフィールドが、前記上位Mビット中の最下位ビットの重み付けに相当する第2の重み付けを有し、前記複数のフレームの数がF個であることを想定すると、各フレームは、($2^{N-M}-1$)/F 個の第1のサブフィールド及び($2^{M}-1$) 個の第2のサブフィールドから構成される。($2^{N-M}-1$)/Fが余りを生じるときには、第1のサブフィールドの個数は、商に1を加えた数である。さらに、第1の重み付けが α であることを想定すると、第2の重み付けは、 α $2^{N-M}/F$ となる。

[0066]

また、階調パターンの数は、第1のサブフィールドの数をbとすると、 2^{M} (b+1)個となる。さらに、前記第1及び前記第2のサブフィールド数の合計が最小となるMの最適解に基づいて、前記階調データを上位ビット及び下位ビット

に分割することが望ましい。なお、上記式は、常時オン状態にすべきサブフィールド及び常時オフ常態にすべきサブフィールドを考慮していない。

[0067]

以下、64階調を3つの連続するフレームを用いて表示する64階調3FRC について説明する。

図24は、第6の実施の形態のサブフィールドを示す。前記階調データは、上位2ビット及び下位4ビットに分割されており、前記上位2ビットについては、該上位ビット中の最下位ビットの重み付けに相当する重み付けを有する3個のサブフィールドSF7~SF9が設けられている。一方、下位4ビットについては、3つのフレーム全体で0~15階調を表示すべく、前記下位4ビット中の最下位ビットの重み付けに相当する重み付けを有する15(=2⁴-1)個のサブフィールドを3つのフレームに分散させて設ける必要がある。したがって、各フレームには、前記下位4ビットについては、5個のサブフィールドが設けられている。要約すれば、各フレームには、上位2ビットに対応するSF7~SF9、下位4ビットに対応するサブフィールドSF1~SF5、及び、常時オンとすべきサブフィールドSF6の合計9個のサブフィールドが形成されている。

図24では、下位ビットに対応するサブフィールドSF1~SF5の個数が5であり、他方、上位ビットに対応するサブフィールドSF7~SF9の個数が3個であることから、サブフィールドを選択する選択パターンがが24 (= (5+1)×(3+1))種類であることが示されている。

[0068]

図25は、64階調3FRCの各フレームでの選択パターンを示す。例えば、階調データが「7」階調(000111)を示すときには、1番めのフレームでは、該1番めのフレームに含まれるサブフィールドのうち、図24に示した選択パターン3を構成するために必要なサブフィールドを選択し、即ち、サブフィールドSF3~SF5を選択し、2番めのフレームでは、該2番めのフレームに含まれるサブフィールドのうち、図24に示した選択パターン2を構成するために必要なサブフィールドを選択し、即ちサブフィールドSF4及びF5を選択し、3番めのフレームでもまた、該3番めのフレームに含まれるサブフィールドのうち

、選択パターン2を構成するために必要なサブフィールドを選択する、即ち、サブフィールドSF4及びSF5を選択する。

[0069]

図21は、第6の実施の形態のデータ変換回路の構成を示し、また、図22は、デコーダが用いる真理値表を示す。データ変換回路300sは、図21に示されるように、上記した第1の実施の形態と同様に、書き込みアドレス制御部310s、表示アドレス制御部330s、フレームメモリ321s、及びデコーダ312sを有する。

[0070]

階調データDO~D5は、ドットクロックDCLKにしたがってフレームメモリに書き込まれ、信号DY等に基づいてデコーダ312sに出力される。デコーダ312sは、信号FRDO~D1、SFDO~D3を供給され、図22に示した真理値表を参照してデコードを行い、そのデコード結果をデータ信号Dsとして出力する。データ変換回路300sは、例えば、階調データDO~D5が「1」階調を示す"00001"であって、FRが00であるとき、即ち1番めのフレームであるとき、SF5が1である旨の信号を出力する。

[0071]

図23は、64階調3FRCの第6の実施の形態の信号の波形を示す。図23 に示される信号の波形は、第1の実施の形態の信号の波形と概ね同一である。

[0072]

以上説明したように、第6の実施の形態によれば、FRC変調を用いることにより、各フレームに設けるべき、重み付けの小さいサブフィールドの個数を低減することができ、これにより、前記重み付けの小さいサブフィールドの長さを長くすることができることから、液晶へのデータ信号の印加を高精度に行うことが容易になる。

[0073]

[第7の実施の形態]

第7の実施の形態の電気光学装置について、図26~図28を参照して説明する。

図27は、第7の実施の形態のサブフィールドを示す。 64 階調 2 FRCでは、2つのフレームを通じて、64 階調を表示する。 64 階調を規定する 6 ビットの階調データは、下位 3 ビットと上位ビット 3 ビットに分割されている。 2 つのフレームで下位 3 ビットが規定する 1 「1 」の 1 8 階調を表示する必要がある。そこで、各フレームには、図 1 2 7に示されるように、下位 1 ビットに対応する 1 個のサブフィールド 1 SF 1 で 1 SF 1 が設けられている。また、各フレームには、図 1 2 7に示されるように、前記上位 1 ビットに対応する 1 7 個のサブフィールド 1 F 1 6 で 1 SF 1 2 が設けられている。図 1 7 には、また、選択パターンの種類が、1 2 (1 (1 (1) (1 (1) (1) (1) 個あることが示されている。

[0074]

図28は、第7の実施の形態の各フレームでの選択パターンを示す。例えば、階調データが「6」階調(000110)を示すとき、1番めのフレームでは、該1番めのフレームに含まれるサブフィールドのうち、図27に示した選択パターン4を構成するために必要なサブフィールドSF1~SF4を選択し、2番めのフレームでは、該2番めのフレームに含まれるサブフィールドのうち、図27に示した選択パターン3を構成するために必要なサブフィールドSF2~SF4を選択する。

[0075]

図26は、第7の実施の形態のデータ変換回路の構成を示す。データ変換回路300tは、上記第6の実施の形態と同様に、書き込みアドレス制御部310t、表示アドレス制御部330t、フレームメモリ321t、及びデコーダ312tを有する。

[0076]

階調データD0~D5は、ドットクロックDCLKにしたがってフレームメモリ321tに書き込まれ、信号DY等に基づいてデコーダ312tに出力される。デコーダ312sは、FRD0~D1、SFD0~D2を供給され、デコードを行い、デコード結果をデータ信号Dsとして出力する。

[0077]

図29は、256階調3FRC用のデータ変換回路の構成を示す。256階調

3 F R C は、データ変換回路が、図29に示されるように、図26に示された6 4 階調2 F R C と同様の構成を有することにより実現することが可能になる。

[0078]

以上説明したように、64階調2FRCの第7の本実施の形態によれば、上記した64階調3FRCの第6の実施の形態と同様に、低階調のためのサブフィールドの期間の長さを長く確保することができることから、たとえ低階調であっても液晶への電圧の印加を精度高く行うことが可能になる。

[0079]

[第8の実施の形態]

第8の実施の形態の電子機器について説明する。

図30は、第8の実施の形態の電子機器の構成を示す。該電子機器は、図30に示されるように、主に、画像信号などの表示情報を出力する表示情報出力源1000と、前記表示情報からデジタル信号を順次生成する表示情報処理回路1002と、上記各実施の形態で説明した電気光学装置1001と、該電気光学装置1001を駆動する、上述した走査線駆動回路130及びデータ線駆動回路140を含む駆動回路1004と、クロック発生回路1008と、電源回路1010とを備えている。第10の実施の形態の代表的な電子機器として、プロジェクタ、モバイル型コンピュータ、及び形態電話器がある。

[0080]

図31は、プロジェクタ、モバイル型のコンピュータ、及び携帯電話器の構成を示す。プロジェクタ1430は、図31(a)に示されるように、液晶光変調装置100R、100G、100Bとして、上記電気光学装置を有し、モバイル型のコンピュータ1200は、図31(b)に示されるように、表示ユニット1206として、上記した電気光学装置100及びバックライトを備えており、携帯電話器1300は、図31(c)に示されるように、表示部100として、上記の電気光学装置を備えている。

[0081]

なお、上記の例で設定した各サブフィールドの重み付けは、液晶の特性等を考慮して調整することも可能である。また、上記の例では、液晶表示装置について

説明したが、エレクトロルミネッセンス(EL)ディスプレイ、プラズマディスプレイやデジタルマイクロミラーデバイス(DMD)ディスプレイ等の電気光学素子にも適用可能である。

[0082]

【発明の効果】

上記したように、本発明の画素の駆動方法によれば、オンを選択すべきサブフィールドの連続性を確保することができることから、階調のずれを改善し、画質を向上することができ、加えて、画素に印加すべき電圧が高周波に変化しないことから、消費電力を低減することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

第1の実施の形態の電気光学装置の構成を示す図である。

【図2】

第1の実施の形態の表示部に設けられている画素の構成を示す図である。

【図3】

第1の実施の形態の電気光学装置の構造を示す図である。

【図4】

第1の実施の形態のデータ線駆動回路の構成を示す図である。

【図5】

第1の実施の形態のスタートパルス発生回路の構成を示す図である。

【図6】

第1の実施の形態のスタートパルス発生回路の動作を示すタイムチャートである。

【図7】

第1の実施の形態のデータ変換回路の構成を示す図である。

【図8】

第1の実施の形態のデコーダが用いる真理値表を示す図である。

【図9】

第1の実施の形態の信号の波形を示すタイムチャートである。

【図10】

第1の実施の形態のサブフィールドを示す図である。

【図11】

第2の実施の形態のスタートパルス発生回路の構成を示す図である。

【図12】

第2の実施の形態のデータ変換回路の構成を示す図である。

【図13】

第2の実施の形態の信号の波形を示すタイムチャートである。

【図14】

第2の実施の形態のサブフィールドを示す図である。

【図15】

第3の実施の形態のスタートパルス発生回路の構成を示す図である。

【図16】

第3の実施の形態のデータ変換回路の構成を示す図である。

【図17】

第3の実施の形態の電気光学装置の動作を示す図である。

【図18】

第3の実施の形態のサブフィールドを示す図である。

【図19】

第4の実施の形態のサブフィールドを示す図である。

【図20】

第5の実施の形態のサブフィールドを示す図である。

【図21】

第6の実施の形態のデータ変換回路の構成を示す図である。

【図22】

第6の実施の形態のデコーダが用いる真理値表を示す図である。

【図23】

第6の実施の形態の信号の波形を示すタイムチャートである。

【図24】

第6の実施の形態のサブフィールドを示す図である。

【図25】

第6の実施の形態の各フレームでの選択パターンを示す図である。

【図26】

第7の実施の形態のデータ変換回路の構成を示す図である。

【図27】

第7の実施の形態のサブフィールドを示す図である。

【図28】

第7の実施の形態の各フレームでの選択パターンを示す図である。

【図29】

第7の実施の形態の他のデータ変換回路の構成を示す図である。

【図30】

第8の実施の形態の電子機器の構成を示す図である。

【図31】

プロジェクタ、モバイル型のコンピュータ、及び携帯電話器の構成を示す図で ある。

【図32】

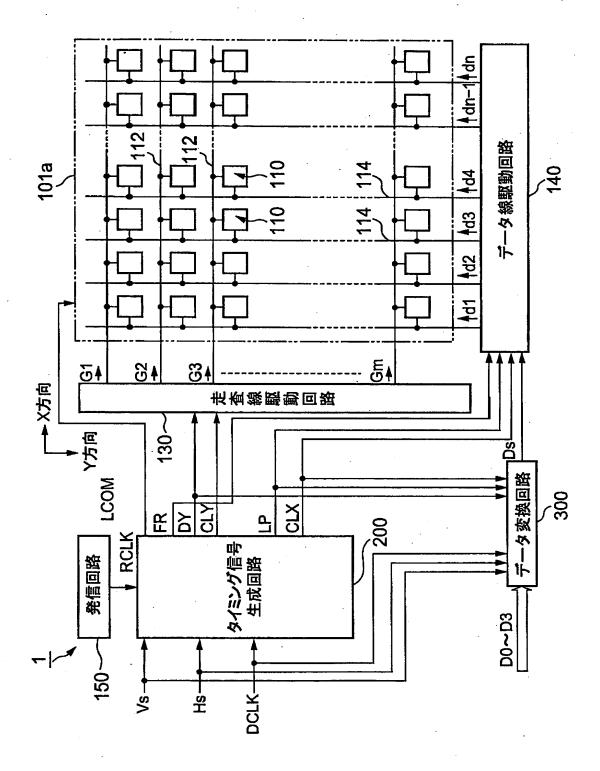
従来のサブフィールドの選択を示す図である。

【符号の説明】

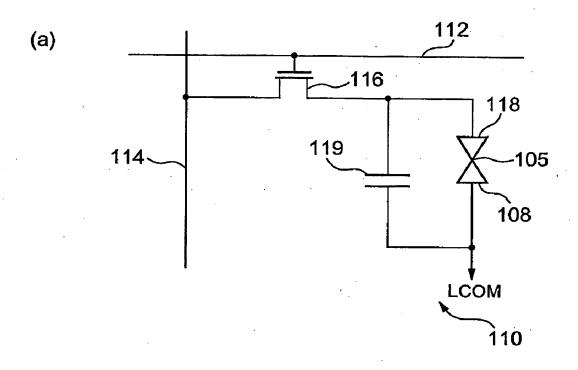
- 101a 表示部
- 150 発振回路
- 200 タイミング信号生成回路
- 300 データ変換回路
- 130 走査線駆動回路
- 140 データ線駆動回路

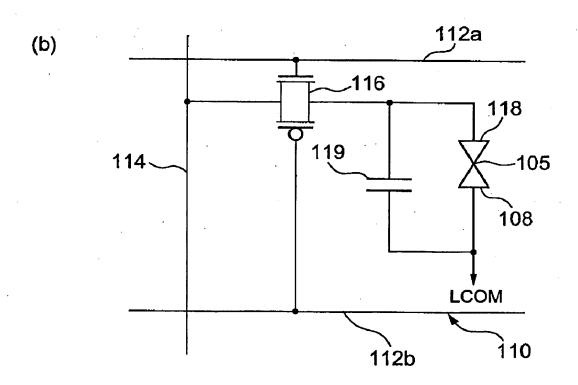
【書類名】図面

【図1】

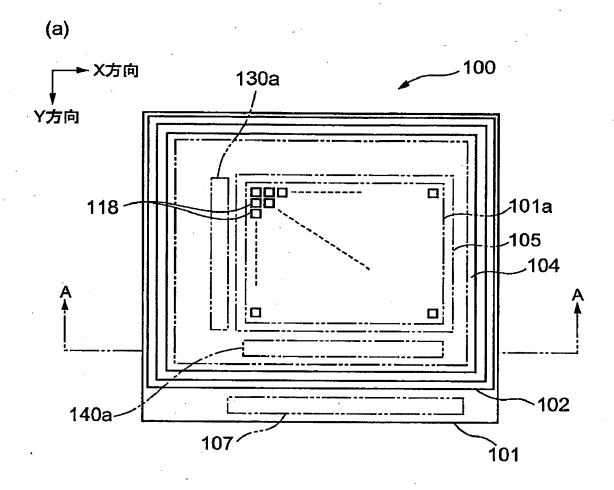


【図2】

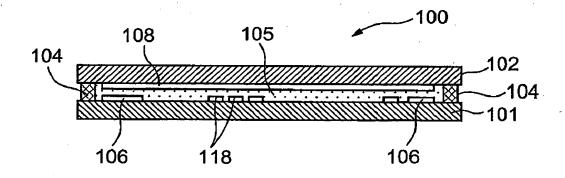




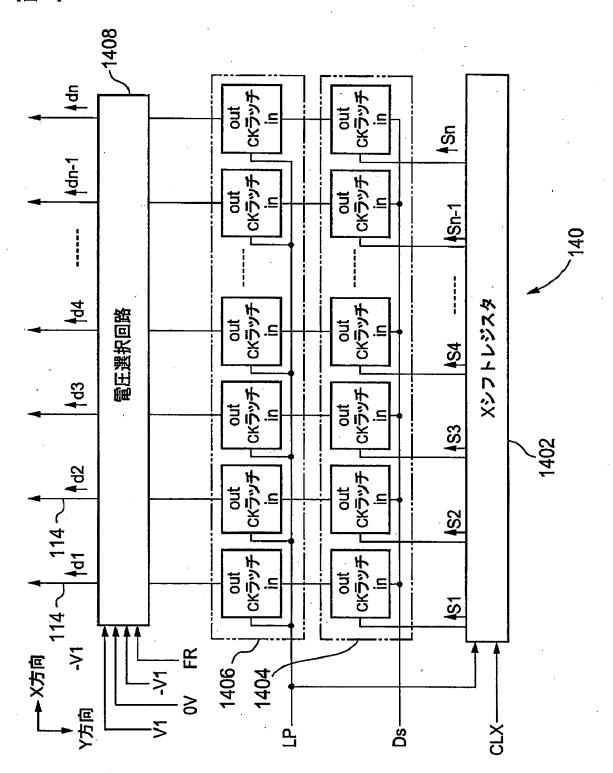
[図3]



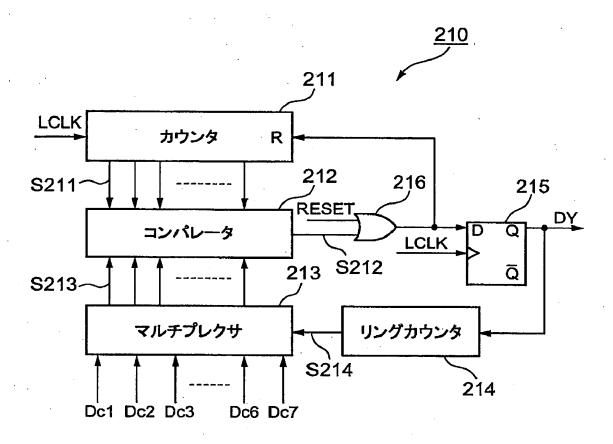
(b)



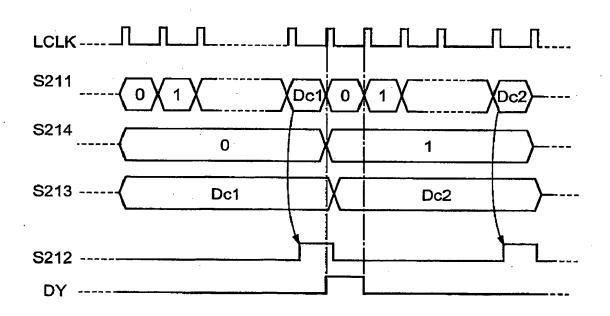
【図4】



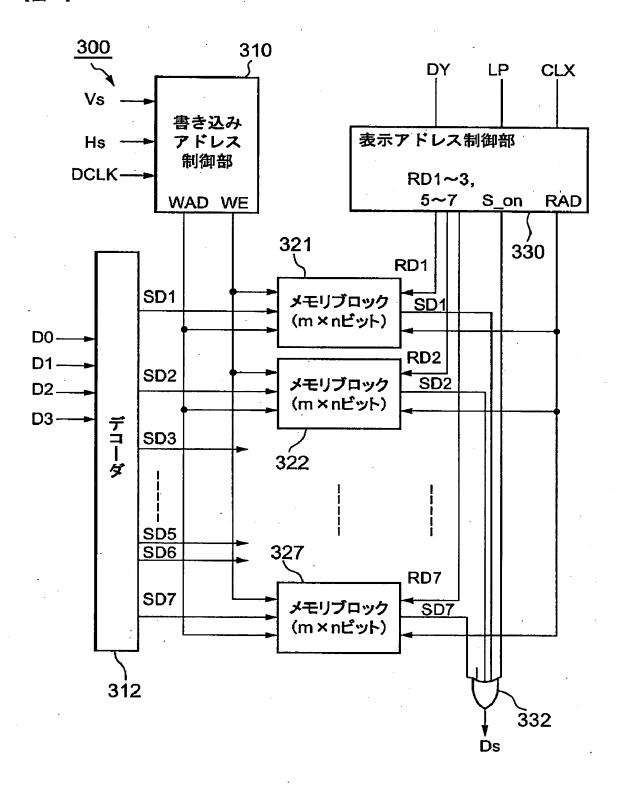
【図5】



【図6】



【図7】

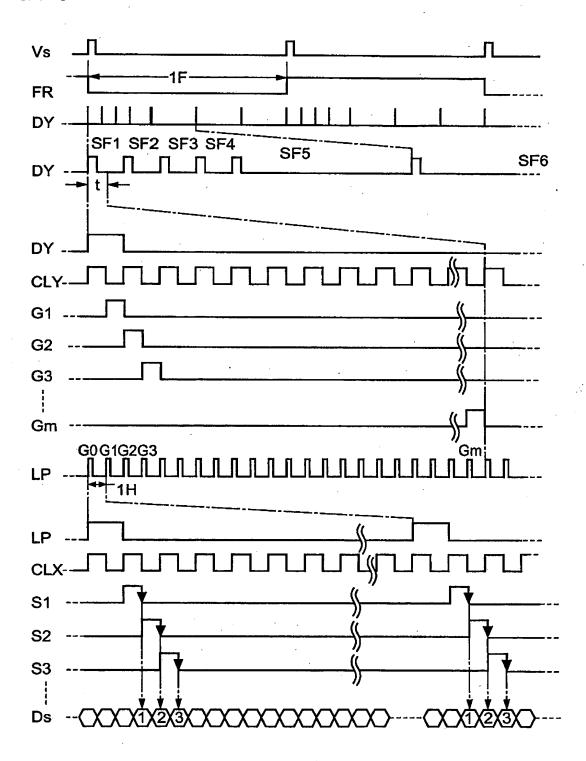


【図8】

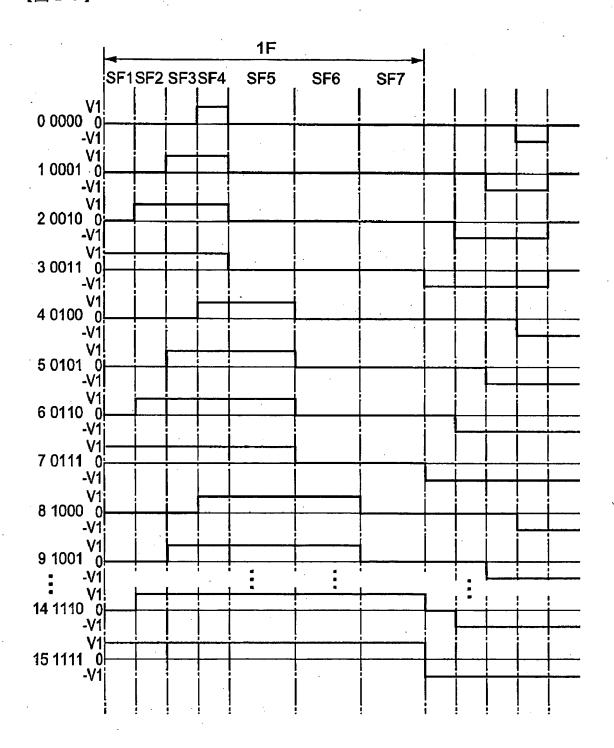
データ変換回路のデコーダ真理値表 (16階調7sf)

	データ	SD1	SD2	SD3	SD5	SD6	SD7
0	0000	0	0	0	0	0	0
1	0001	0	0	1	0	0	0
2	0010	0	1	1	0	0	0
3	0011	1	1	. 1	0	. 0	0.
4	0100	0	0	0	1	0	0
5	0101	0	0	1	1	0	0
6	0110	0	1	1	1	0	0
7	0111	1	1	1	1	0	0
8	1000	0	0	0	1	1	0
9	1001	0	0	1	1	1	0
10	1010	0	1	1	1	1	0
11	1011	1	1	1	1	1	0
12	1100	0	0	0	1	1	1
13	1101	0	0	1	1	1	1
14	1110	0	1	1	1	1	1
15	1111	1	1	1	1	1	1

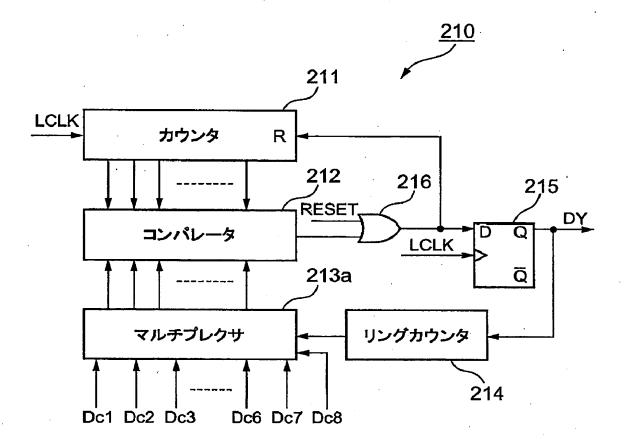
【図9】



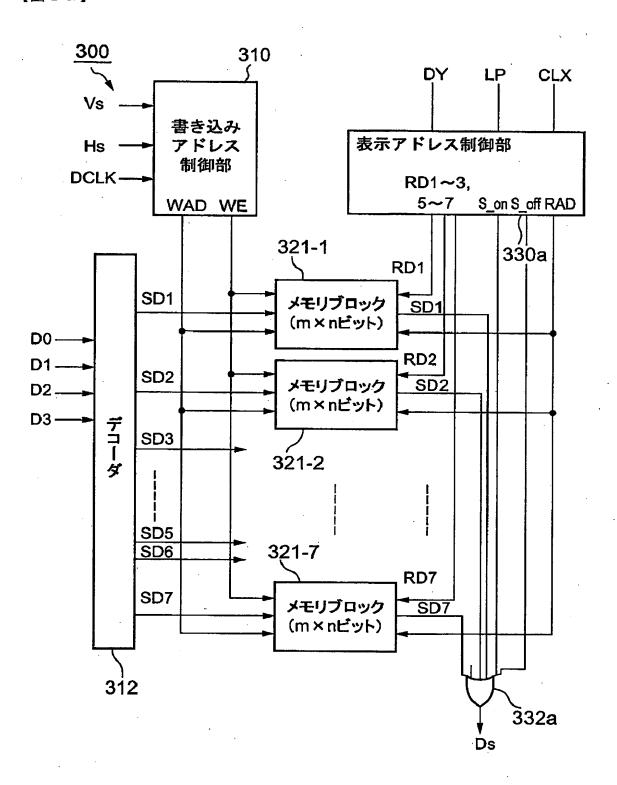
【図10】



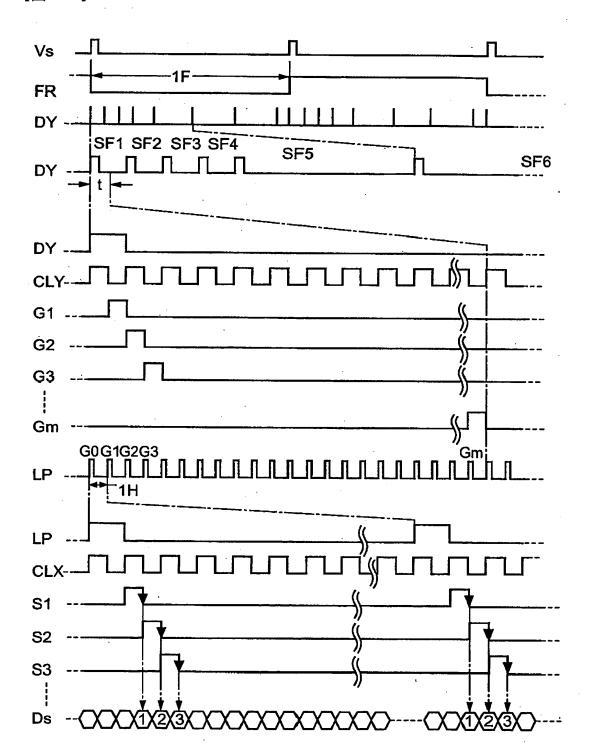
【図11】



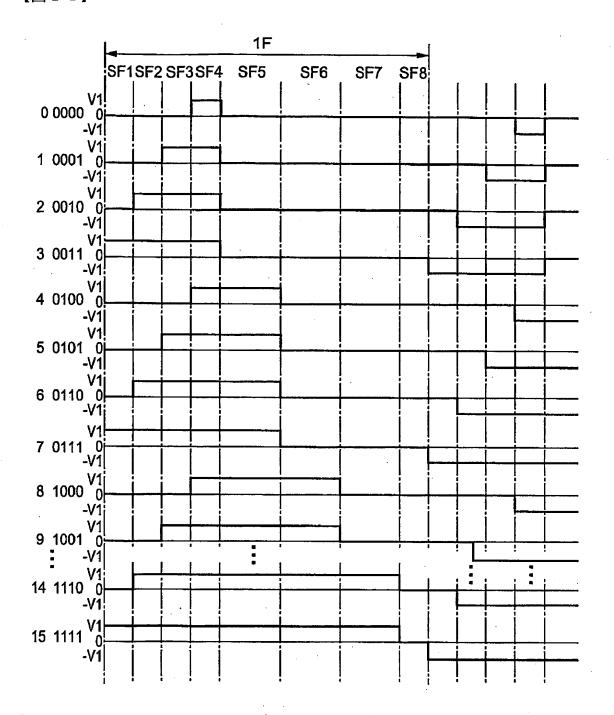
【図12】



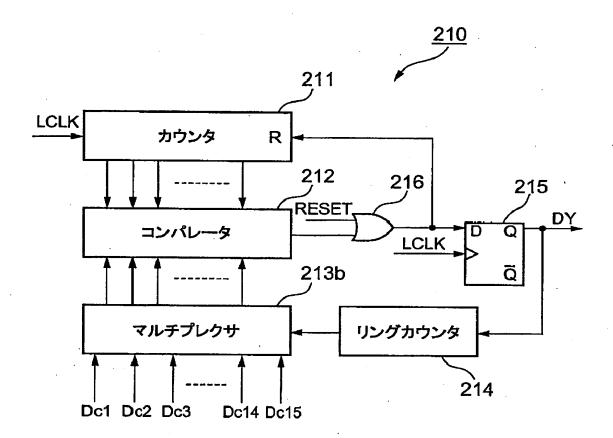
【図13】



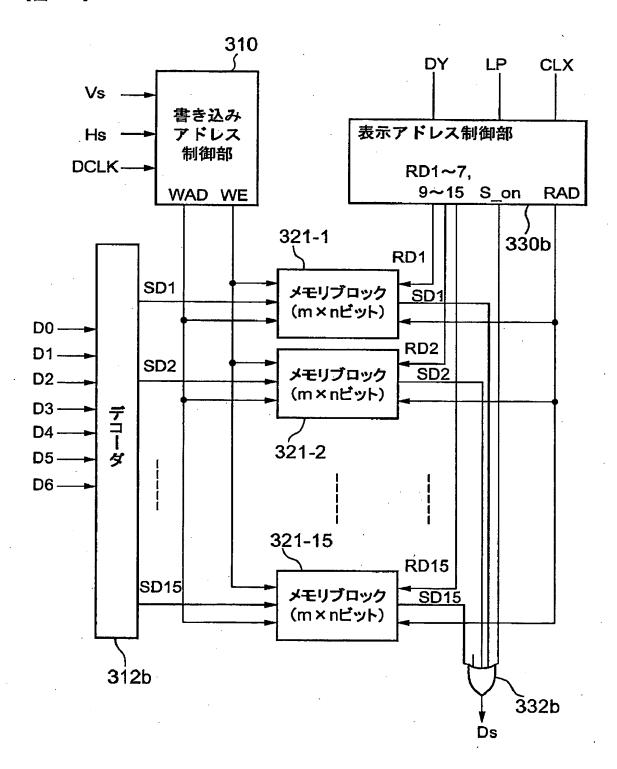
【図14】



【図15】

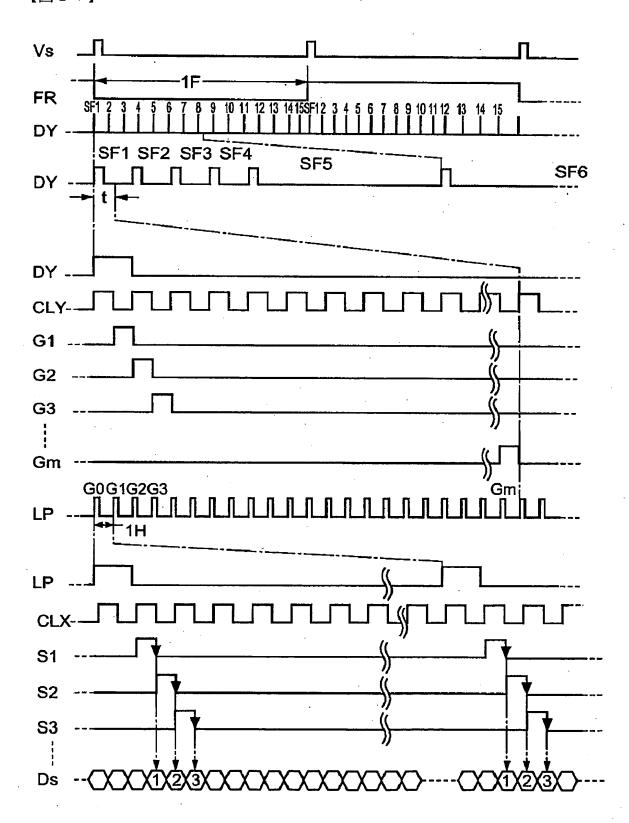


【図16】

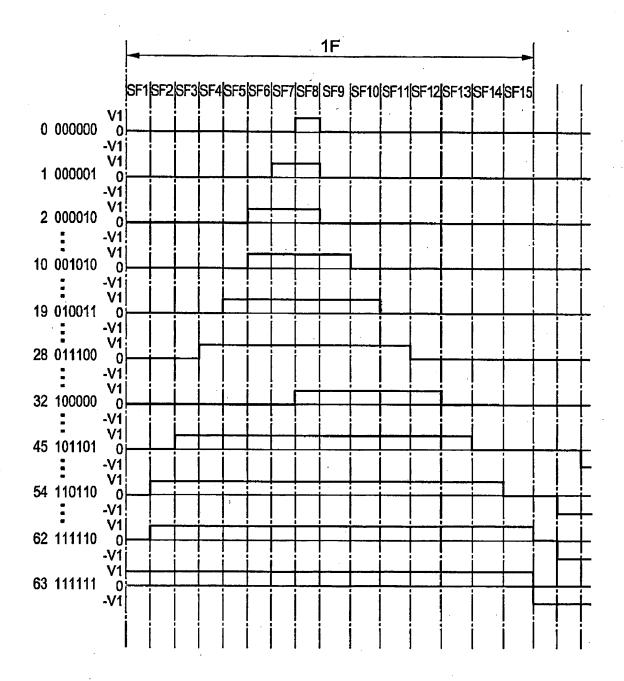


1 5

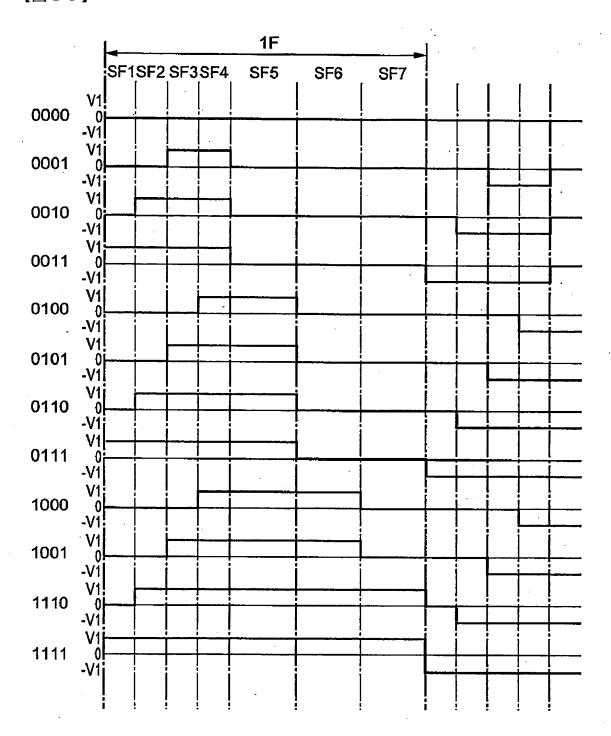




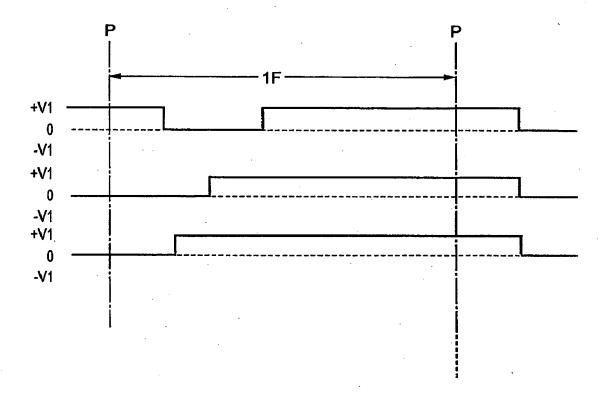
【図18】



【図19】

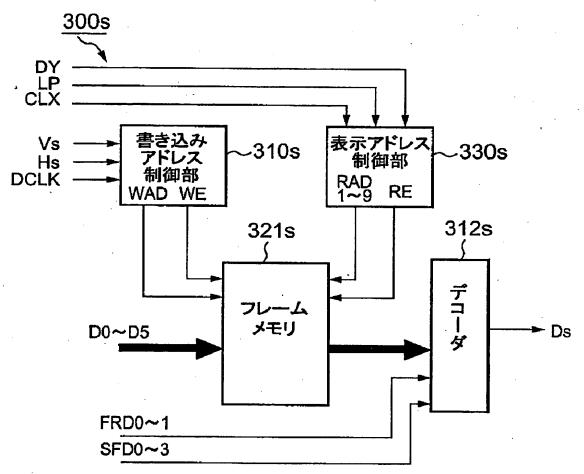


【図20】



【図21】

64階調(3FRC)のデータ変換回路ブロック図

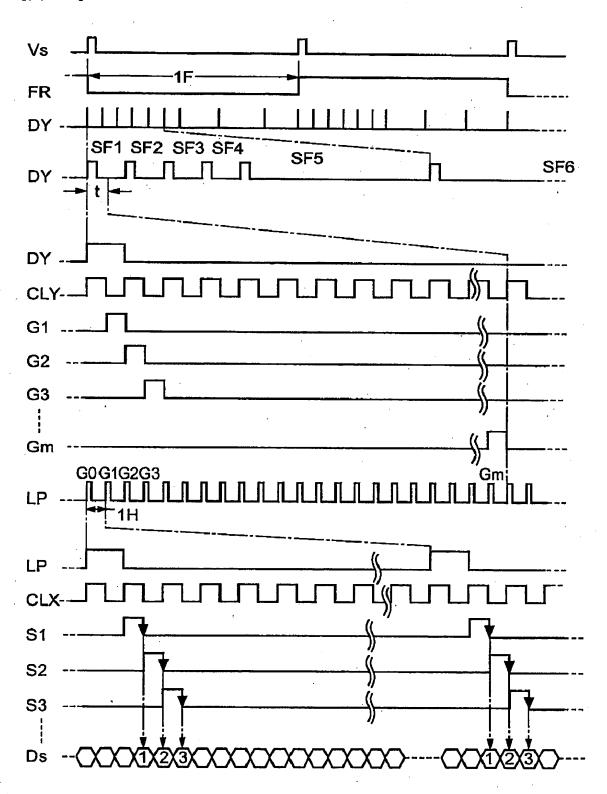


【図22】

64階調 (3FRC) のデータ真理値表

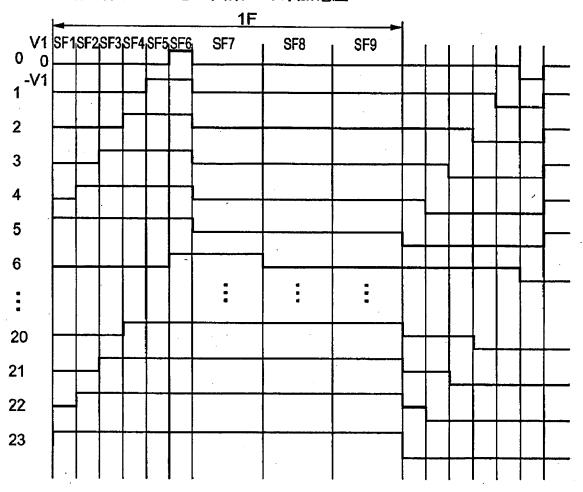
データ	FR	Sf1	Sf2	Sf3	Sf4	Sf5	Sf6	Sf7	Sf8	Sf9	
000000	00	0	0	0	0	0	1	0	0	- 0	FR1
000000	01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	FR2
000000	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	FR3
000001	00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	FR1
000001	01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	FR2
000001	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	FR3
000010	00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	FR1
000010	01	0	0	0	0	1	11	0	0	0	FR2
000010	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	FR3
000011	00	0	0	0	0	1	1	0	0	0	FR1
000011	01	0	0	0	0	1	1	-0	0	0	FR2
000011	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	FR3
000100	00	0	0	0	1	1	1	0	0	0	FR1
000100	01	0	0	0	0	1	1	0	0	0	FR2
000100	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	FR3
000101	00	0	0	0	1	1	1	0	0	0	FR1
000101	01	0	0	0	1	1	1	0	0	0	FR2
000101	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	FR3
											Ì
111011	00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	FR1
111011	01	0	1	1	1	1	11	11	1	1	FR2
111011	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	FR3
111100	00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	FR1
111100	01	0	1	1	1	1	1	1	1	1	FR2
111100	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	FR3
111101	00	1	1	1	1	1	1_	1	1	1	FR1
111101	01	0	1	1	1	1	1	1	1	1	FR2
111101	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	FR3
111110	00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FR1
111110	01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FR2
111110	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	FR3
111111	00	1	1	1	1	1.	1	1	1	1	FR1
111111	01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FR2
111111	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FR3

【図23】



【図24】

64階調表示のときの画素への印加電圧



2 3

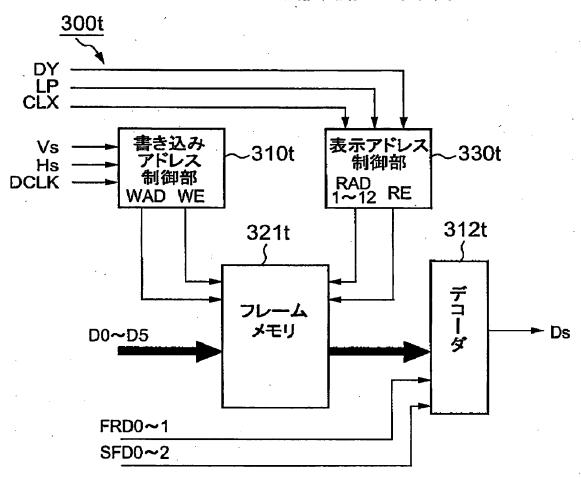
【図25】

64階調(3FRC)

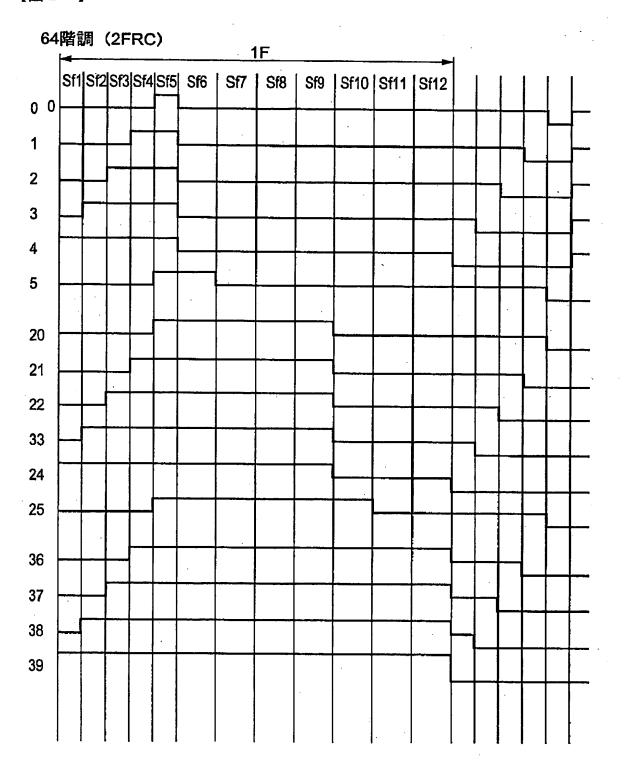
データ	FR1	FR2	FR3
000000	0	0	0
000001	1	0	0
000010	1	1	0
000011	1	1	0
000100	2	1	1
000101	2 2 2 3	2 2 2	1
000110	2	2	2 2
000111	3	2	2
010000	<u>6</u> 7	6	6
010001	7	6	6
010010	7	7	6
010011	7	7	7
,			
100000	12	12	12
100001	13	12	12
100010	13	13	12
100011	13	13	13
111100	22	22 22	22
111101	23	22	22 22 22
111110	23	23	22
111111	23	23	23

【図26】

64階調 (FRC) のデータ変換回路ブロック図



【図27】



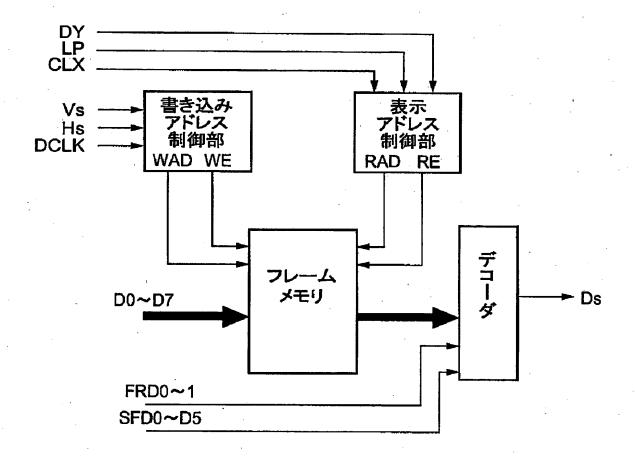
【図28】

64階調(2FRC)

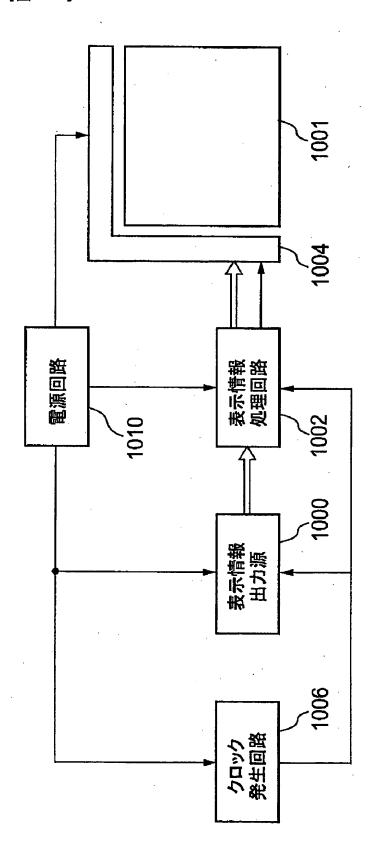
データ	FR1	FR2
000000	1	0
000001	1	1
000010	2	1
000011	2 2 3 3	2
000100	3	2
000101	3	2 3 3
000110	4	3
000111	4	4
001000	6	5
001001	6	6
010000	11	10
010001	11	11
010010	12	11
010011	12	12
-	·	
100000	21	20
100001	21	21
100010	22	21
100011	22	22
111100	38	37
111101	38	38
111110	39	38
111111	39	39
	·	

【図29】

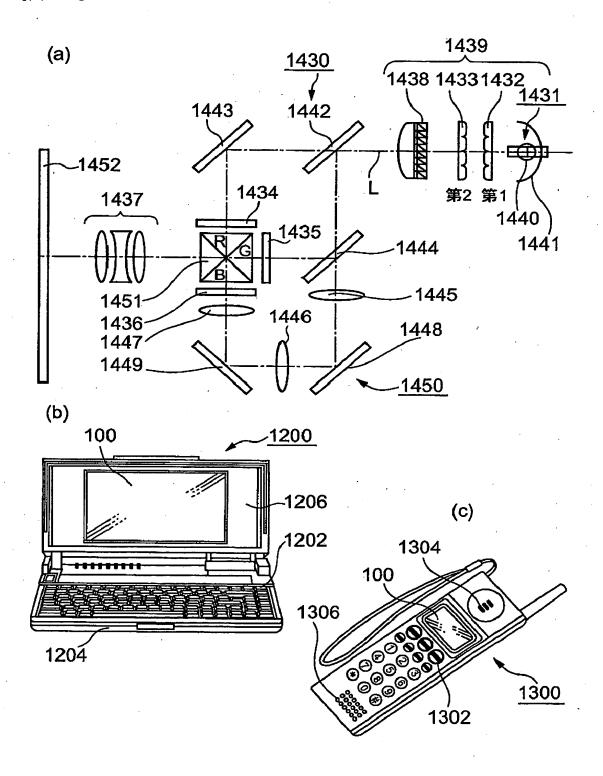
階調(FRC)のデータ変換回路ブロック図



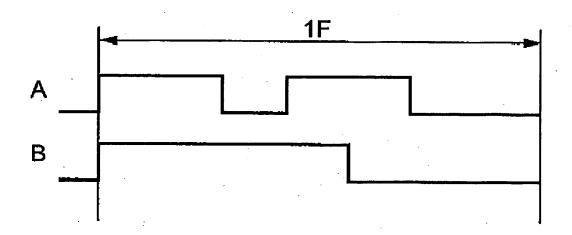
【図30】



【図31】



【図32】



特2001-294702

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 選択されるサブフィールド同士の位置関係の無規則性に起因して、異なる階調を表示する。

【解決手段】 本発明に係る画素の駆動方法は、相互に連続する複数の第1のサブフィールド期間、及び該複数の第1のサブフィールド期間に連続する、相互に連続する複数の第2のサブフィールド期間を、前記複数の第1のサブフィールド期間及び前記複数の第2のサブフィールド期間の境界を基点に離れる方向に、階調データに従って順次選択する選択ステップと、選択された前記サブフィールド期間の間、前記画素をオンにする駆動ステップとを含む。

【選択図】 図10

特2001-294702

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2001-294702

受付番号

50101419280

書類名

特許願

担当官

第二担当上席

0091

作成日

平成13年10月 1日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【住所又は居所】

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

【氏名又は名称】

セイコーエプソン株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100095728

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプ

ソン株式会社 知的財産部室 内

【氏名又は名称】

上柳 雅誉

【選任した代理人】

【識別番号】

100107076

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプ

ソン株式会社 知的財産室内

【氏名又は名称】

藤綱 英吉

【選任した代理人】

【識別番号】

100107261

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプ

ソン株式会社 知的財産部室 内

【氏名又は名称】

須澤 修

出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日

1990年 8月20日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名

セイコーエプソン株式会社